

半导体学报

第 11 卷 第 2 期 1990 年 2 月

目 录

- 关于 AlGaAs:Si 中 DX 中心的新观点
.....李名复 贾英波 周 洁 高季林 于 鑫 (81)
- GaAs/AlAs 短周期超晶格的静压光致发光研究
.....李国华 江德生 韩和相 汪兆平 K. Ploog (88)
- GaAs/AlGaAs 多量子阱结构的光吸收谱和横向光电流谱
.....滕 达 徐仲英 庄蔚华 王守武 (97)
- Si(100)-As 表面钝化作用和氧吸附.....钟战天 王大文 范 越 李承芳 (104)
- 抗反射条定域再结晶方法在 SOI 技术中的应用
.....杨晓军 马腾阁 张继盛 钱佩信 (111)
- 改进的“带宽最小化” BBL 布局算法朱家璧 陈允康 (118)
- 应用于 VLSI 的 PSSWS-LDD MOSFET 优化工艺研究
.....徐大林 王 方 李荫波 彭忠献 黄 徽 (127)
- 研究简报**
- 非对称轻掺杂漏(LDD)MOSFET.....陈学良 王自惠 (136)
- Si, As 双注入 GaAs 的 RTA 研究
.....朱德华 李国辉 张通和 王玉琦 孙贵如 (140)
- p-n 结电场分布的一种解析法.....李肇基 李忠民 陈星弼 (144)
- Au-GaAs (III)界面特性的研究.....何丕模 罗晋生 刘 古 (148)
- GaAs 基片上制作优质衍射光栅的实时监测技术的分析
.....谢建平 明 海 多田邦雄 (153)
- 研究快报**
- 混合抛物面反射二维面发射可见光半导体激光器.....
.....张晓波 杜国同 高鼎三 (158)